

## InGaAs APD雪崩光电二极管

### 特点:

高响应度  
 高速  
 平面正照型  
 TO-Can 封装或带尾纤输出  
 最大可用增益达到 20



### 应用:

光通讯接收设备  
 CATV 接收机  
 OTDR

### 最大额定值:

工作温度 (°C)	-40~+85	反向电流连续 (mA)	3
存储温度 (°C)	-55~+85	反向电压 (V)	30
焊接温度 (°C)	260	正向电流连续 (mA)	10
焊接时间 (s)	10		

### 光电特性 (T = 22°C)

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值
光谱响应范围 (nm)	$\lambda$		1000		1700
光敏面直径(um)			$\phi 50$		
响应度 (A/W)	Re	$\lambda=1.55\mu\text{m}, M=10, \phi=1\mu\text{w}$	8.0	8.5	
击穿电压 (V)	VBR	$I_D=100\mu\text{A}, \phi=0$	30		60
击穿电压温度系数 (V/°C)	$\delta$	$T_C=-40\sim+85^\circ\text{C}$		0.1	0.15
暗电流 (nA)	$I_D$	$M=10, \phi=0$		1	10
总电容 (pF)	$C_{\text{tot}}$	$M=10, \phi=0, f=1\text{MHz}$		0.6	1.0
响应时间 (ns)	$f_T$	$M=10, \phi=0, \lambda=1.55\mu\text{m}$	0.15	0.3	0.5
最大可用增益	$M_{\text{max}}$	$V_R=0.98V_{\text{BR}}$	20		
推荐工作电压 (*VBR)	$V_R$	$M=10, \phi=1, \lambda=1.55\mu\text{m}$	0.9		0.95

具体性能指标见每支器件参数